

بهنام یگانه‌ی هستی



دانشگاه الزهراء (س)

دانشکده علوم پایه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته فیزیک اتمی و مولکولی

عنوان

ساخت نانولایه‌های کربن شبه الماسی به روش پلاسمای DC

استاد راهنما

دکتر عزیرالله شفیع خانی
دکتر محمود رضا روحانی

استاد مشاور

دکتر محمدعلی وساقی

دانشجو

مریم جعفری

۱۳۸۹ مهر

تقدیم به

پدر و مادر مهربانم

که در تمام مراحل زندگی همراه و پشتیبانم بوده‌اند.

و همسر عزیزم

که مهربانیش آرامش روانم و حمایتش پرپروازم است.

قدردانی و تشکر

سپاس خداوند مهربان را که یگانه شاهراه حقیقت است.
در اینجا لازم می‌دانم از زحمات و راهنمایی‌های استاد گرامی خود، آقای دکتر شفیع‌خانی، که با کمال دقت و
حواله و با در اختیار گذاشتن تجربیاتشان، همواره در مسیر پژوهش مشوق من بودند، تشکر نمایم.
از سرکار خانم دکتر سجاد و جناب آقای دکتر حیدرثانی که مسئولیت داوری این پژوهه را پذیرفتند، قدردانی
می‌نمایم.

چکیده

لایه‌های کربن شبه‌الماسی، DLC، ساختاری آمورف و شبه‌پایدار از اتم‌های کربن و هیدروژن هستند که به دلیل خواص مختلفی چون سختی مکانیکی بالا، مقاومت الکتریکی بالا و شفافیت اپتیکی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته‌اند.

خواص این لایه‌های نازک، تابع شرایط تهیه بوده و با تغییر شرایط می‌توان بعضی خواص فیزیکی و اپتوالکتریکی آن‌ها را تغییر داد.

هدف ما در این تحقیق، ساخت لایه‌های نازک کربن شبه‌الماسی به روش پلاسمای DC بر روی زیرلایه‌های مختلف در زمان‌های انباست متفاوت است. سعی شده است اثر این عوامل، بر روی خواص مختلف لایه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. سایر عوامل مانند فشار اولیه‌ی گاز ورودی و فاصله الکتروودها در همه‌ی نمونه‌ها ثابت نگه‌داشته شده‌اند.

پس از طی مراحل ساخت، برای مشخصه‌یابی، آنالیزهای XRD، FT-IR، UV-vis و SEM بر روی نمونه‌ها انجام شده است. با استفاده از روابط کرامرز – کرونیگ و روابط فرنل، ضریب شکست و ضخامت لایه‌های شبه‌الماسی محاسبه شده است.

روابط کرامرز – کرونیگ بر پایه طیف جذبی FT-IR در محدوده $2800 - 3100 \text{ cm}^{-1}$ و تابش نزدیک به عمود، ضریب شکست را تعیین می‌کند و سپس با استفاده از طیف UV-vis و نتایج حاصل از روابط کرامرز – کرونیگ در روابط فرنل، ضخامت لایه‌ها مشخص می‌شود.

فهرست

١ كربن و أنواع آن

١	كربن
٢	الماس
٣	خواص الكتروني
٤	خواص اپتني
٤	ویژگی گرمایی
٥	ساير خواص فیزیکی
٥	خواص شیمیایی
٥	گرافیت
٧	فلورن
٧	كربن شبه الماسى
٨	(a-C) و (ta-C) كربن آمورف

۹ کربن آمورف هیدروژن دار (ta-C:H) و (a-C:H)

۱۱ خواص لایه های شبه الماسی کربن

۱۲ کاربردهای لایه های شبه الماسی کربن

۲ تکنیک خلاء و روش های لایه نشانی

۱۴ خلاء و سیستم های خلاء

۱۴ خلاء

۱۵ پمپ های خلاء

۱۶ پمپ روغنی گردشی

۱۷ الف) پمپ روغنی گردشی بدون *gasballast*

۱۸ ب) پمپ روغنی گردشی با *gasballast*

۱۸ مزیت استفاده از پمپ با *gasballast*

۱۹ پمپ روغنی انتشاری

۲۰ سنجش خلاء

۲۰ لوله گایسلر

۲۱ خلاء سنج پیرانی

۲۱ خلاء سنج پنینگ

۲۱ خلاء سنج یونی با قطب منفی داغ

۲۲ — خلاء سنج یونی از نوع *A - B* —

۲۲	لایه‌های نازک
۲۲	لایه‌های نازک
۲۲	زیرلایه
۲۳	نقص در لایه نازک
۲۴	روش‌های لایه نشانی
۲۵	لایه‌نشانی فیزیکی بخار
۲۵	تبخیر در خلاء
۲۷	کندوپاش
۲۸	لایه نشانی به روش باریکه مولکولی
۲۸	لایه‌نشانی شیمیایی بخار
۲۹	مکانیزم رشد لایه در روش شیمیایی بخار
۲۹	فرایندهای شیمیایی در لایه‌نشانی شیمیایی بخار
۳۰	مزایای استفاده از لایه‌نشانی شیمیایی بخار
۳۱	معایب استفاده از لایه‌نشانی شیمیایی بخار
۳۲	سیستم‌های <i>CVD</i>
۳۳	روش پلاسمای <i>DC – CVD</i>
۳۳	روش پلاسمای <i>RF – CVD</i>
۳۴	روش پلاسمای <i>MW – CVD</i>

۳۴	مکانیزم رشد لایه و عوامل موثر بر رشد
۳۵	انواع رشد
۳۷	عوامل موثر بر رشد لایه‌های نازک

۳ مشخصه‌یابی لایه‌های نازک

۴۰	طیف‌سنجدی در ناحیه مرئی و فرابنفش ($UV - vis$)
۴۲	طیف‌سنجدی فروسرخ (IR)
۴۴	طیف‌سنجدی تبدیل فوریه ($FT - IR$)
۴۷	طیف‌سنجد پراش پرتو ایکس (XRD)
۵۰	میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)
۵۲	آشکارسازهای الکترون
۵۳	آماده سازی نمونه جهت بررسی در (SEM)

۴ خواص اپتیکی لایه‌های نازک

۵۵	ضخامت
۵۶	روش‌های تداخلی اندازه‌گیری ضخامت
۵۹	پاشندگی نوری در مواد
۵۹	مدل نوسانگ هماهنگ درود – لورنتس
۶۱	رابطه کرامرز – کرونینگ
۶۲	گاف انرژی اپتیکی

۵ آماده سازی و ساخت نمونه‌ها

۶۵	محفظه خلاء
۶۶	آماده سازی زیر لایه
۶۷	ساخت نمونه‌ها

۶ بررسی نتایج

۶۹	مقدمه
۷۰	بررسی نمودار انباشت
۷۱	بررسی آنالیز <i>XRD</i>
۷۲	بررسی آنالیز <i>SEM</i>
۷۴	اندازه‌گیری گاف انرژی اپتیکی
۷۸	بررسی هیبریداسیون‌های مختلف با استفاده از طیفسنجی <i>FT - IR</i>
۸۲	مقایسه آهنگ تغییرات و گاف اپتیکی نسبت به زمان انباشت (sp^2/sp^3)
۸۴	محاسبه ضریب شکست و ضخامت لایه‌های تهیه شده
۸۴	الف) محاسبه <i>Nd</i>
۸۷	ب) محاسبه ضریب شکست
۹۰	ج) محاسبه ضخامت
۹۱	مقایسه چگونگی تغییرات ضخامت و فشار کمینه نسبت به زمان انباشت
۹۳	محاسبه ثابت دی الکتریک

نتیجه‌گیری

۹۶

مراجع

۹۸

چکیده‌ی انگلیسی

فصل اول

کربن و انواع آن

کربن

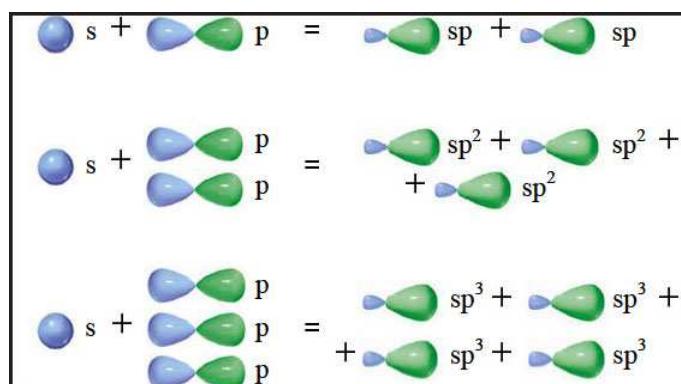
کربن یکی از فراوان‌ترین عناصر سطح زمین و عامل مهم تشکیل‌دهنده‌ی مواد آلی است. این عنصر با عدد اتمی ۶ و وزن اتمی $12/0\text{ }11$ در گروه چهارم جدول تناوبی عناصر قرار دارد. اتم کربن به دلیل ساختار پیوندی خاص و شعاع اتمی کوچک خود، ترکیبات بی‌شماری با سایر اتم‌های کربن و یا با اتم‌های عناصر دیگر می‌سازد. در نتیجه ترکیباتی به وجود می‌آورد که می‌توانند بسیار بی‌نظم و یا کریستالی باشند.

کربن با ساختار الکترونی $1s^22s^22p^2$ ، دارای دو الکترون است که شدیداً به هسته مقید هستند و به الکترون‌های مغزی مشهورند ولی چهار الکترون آخر به طور ضعیف به هسته مقیدند و الکترون‌های ظرفیت و یا والانس نام دارند، در حالت متبلور اوربیتال‌های تراز آخر $2p_x\text{ }2p_y\text{ }2p_z$ هستند که نقش اساسی در تشکیل پیوند‌های کوالانسی در مواد کربنی دارند.

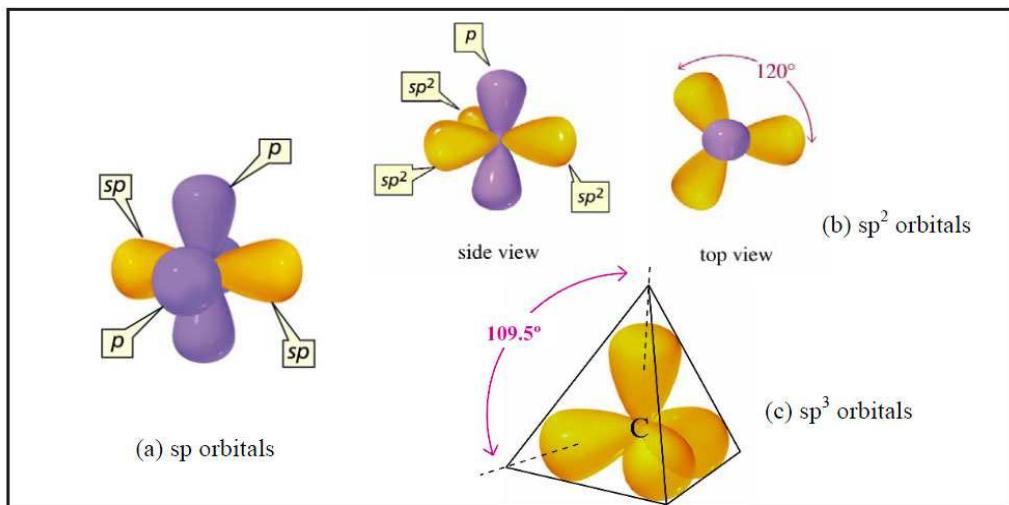
از آنجایی که اختلاف انرژی میان تراز $2s$ و $2p$ در اتم کربن نسبت به انرژی بستگی پیوند‌های شیمیایی کم است، توابع موج الکترونی این چهار الکترون به آسانی با هم مخلوط می‌شوند. بنابراین پیوند اوربیتال‌های اتمی

به وجود آمده با اتم‌های مجاور قوی‌تر می‌شود.

فرایند مخلوط شدن اوربیتال‌های $2s$ و $2p$ را هیبریداسیون می‌نامند. در واقع هیبرید شدن مربوط به فرایندی است که در آن، حالت‌ها را دیگر نمی‌توان به صورت s یا p مشخص کرد، بلکه مخلوطی از حالت‌های s یا p هستند.



شکل (۱-۱) ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی و تشکیل انواع هیبریداسیون.



شکل (۱-۲) انواع هیبریداسیون.

کربن می‌تواند هیبریداسیون‌های مختلف داشته باشد. در هیبریداسیون sp^n ، $n+1$ پیوند σ به ازای هر اتم کربن وجود دارد.

در هیبریداسیون sp دو پیوند σ یک زنجیر یک بعدی را می‌سازند، که این ساختارها به کربن‌ها مشهور هستند. هیبریداسیون sp^2 یک ساختار صفحه‌ای می‌سازد که ماهیتی دو بعدی دارد و گرافیت نمونه‌ای از آن است. در هیبریداسیون sp^3 چهارپیوند σ یک چهاروجهی می‌سازند که تشکیل‌دهنده یک ساختار سه بعدی است، نمونه‌ای از این هیبریداسیون، الماس می‌باشد.

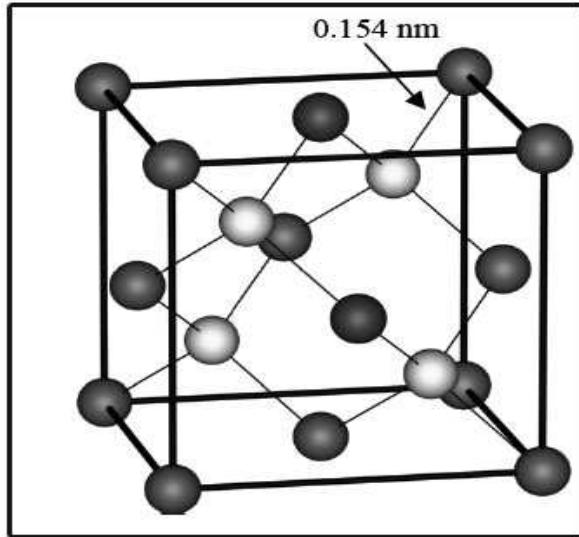
الماس

الماس یکی از حالت‌های کریستالی کربن است که نظم بلندبرد دارد. در الماس هر اتم کربن با چهار اتم مجاور خود، پیوند کوالانسی از نوع sp^3 برقرار می‌کند. ساختار بلوری الماس دو شبکه در هم فرو رفته fcc است که به اندازه $1/4$ قطر مکعب جایه‌جا شده‌اند. ثابت شبکه در ساختار کریستالی $nm / 354 \circ$ و طول پیوند آن $nm / 154 \circ$ است [۲]. ویژگی‌های الماس در برابر حضور ناخالصی‌ها بسیار حساس هستند. حضور حتی مقدار کمی از یک عنصر خارجی مثل نیتروژن می‌تواند به شدت خواص الماس را تغییر دهد.

ناخالصی می‌تواند به جای اتم کربن قرار گیرد و هم‌چنین می‌تواند شامل عناصری باشد که قسمتی از شبکه نیستند مثل Al و Si. دو ناخالصی مهم شبکه که در الماس یافت می‌شوند بورون و نیتروژن هستند. نیتروژن و بورون همسایه‌های کربن در جدول تناوبی هستند که شعاع اتمی آن‌ها کوچک است و به آسانی در ساختار الماس منطبق می‌شوند [۱].

خواص الکتریکی

الماس دارای گاف انرژی غیرمستقیم و بسیار عریض می‌باشد. بنابراین الماس یکی از بهترین عایق‌های الکتریکی است. در الماس خالص مقاومت ویژه بزرگ‌تر از $10^{18} \Omega \cdot m$ است. به هر حال حضور هر نوع ناخالصی



شکل (۱-۳) ساختار کریستالی الماس.

می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای ترازهای الکترونی را تغییر دهد.

خواص اپتیکی

گاف اپتیکی الماس در صفر کلوین $5/4$ eV است. این امر باعث می‌شود که این ماده از فروسرخ تا فرابنفش شفاف باشد. بنابراین الماس قادر است دامنه‌ی وسیعی از طول موج‌ها را عبور دهد. هم‌چنین الماس دارای ضریب شکست بسیار بالا می‌باشد. در $\lambda = 5\mu\text{m}$ دارای ضریب شکست $2/42$ است.

ویژگی گرمایی

یکی از ویژگی‌های بر جسته الماس، هدایت گرمایی بالای آن است (هدایت گرمایی آن تقریباً ۵ برابر مس است) [۲]. ارتعاشات شبکه در الماس، هنگامی به وجود می‌آید که اتمهای کربن به وسیله یک منبع انرژی مثل منبع گرمایی برانگیخته شوند. اتم‌های کربن هم کوچک هستند و هم جرم کمی دارند و در ساختار الماس به صورت همسان و محکم به هم متصل شده‌اند. بنابراین انرژی لازم برای مرتعش کردن این اتم‌ها بسیار بالا

است. این بدان معنی است که اکثر ارتعاشات در فرکانس‌های بالا و در حدود 10^{12}Hz اتفاق می‌افتد. هدایت گرمایی در K_{100} به بیشینه‌ی خود می‌رسد ولی با افزایش بیشتر دما، چون تعداد فونون‌ها زیاد و درنتیجه پراکندگی آن‌ها افزایش می‌یابد، هدایت گرمایی کاهش پیدا می‌کند. همچنین حضور ناخالصی‌ها هم باعث کاهش رسانندگی گرمایی می‌شود.

پیوندهای قوی در الماس باعث می‌شوند که انبساط گرمایی آن بسیار کم باشد ولی بر خلاف گرافیت، الماس دارای انبساط گرمایی همسانگرد است و انبساط گرمایی آن با افزایش دما افزایش می‌یابد.

سایر خواص فیزیکی

الماس به عنوان سخت‌ترین ماده بر روی زمین شناخته شده است و همچنین دارای بالاترین چگالی تعداد اتم‌ها در میان جامدات است. مدول یانگ بالا، تنش کششی زیاد، ضریب اصطکاک پایین و دمای ذوبی در حدود 4000°C از دیگر خواص فیزیکی الماس می‌باشند.

خواص شیمیایی

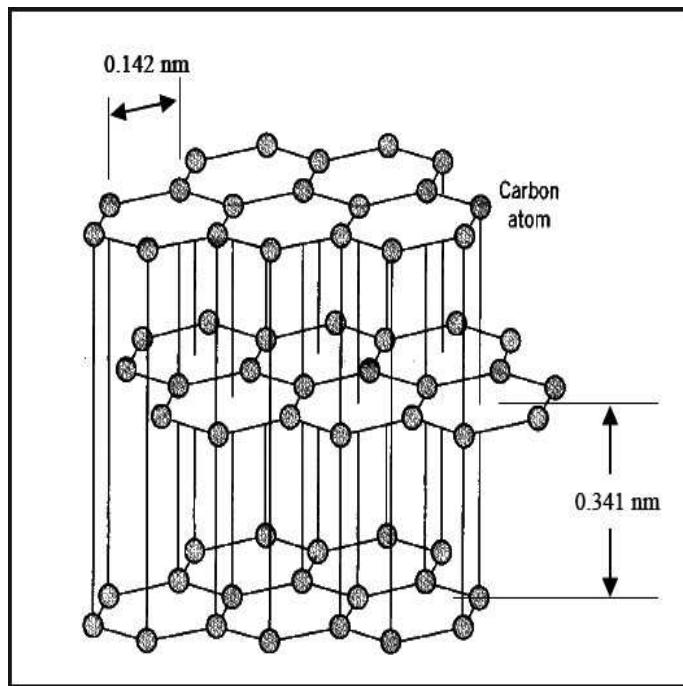
الماس از لحاظ شیمیایی کاملاً خنثی است و پایداری شیمیایی بالایی دارد. با بیشتر اسیدها و بازها واکنش نمی‌دهد و خوردگی در آن اتفاق نمی‌افتد.

گرافیت

گرافیت ماده‌ای بسیار نرم است که ساختار لایه‌ای دارد. اتم‌های کربن در هر لایه، با پیوندهای sp^2 با سه اتم همسایه خود مربوط می‌شوند. بنابراین در درون صفحه اتصالات ۶ وجهی با پیوندهای قوی σ ایجاد می‌شود. الکترون والنس باقی‌مانده با یک پیوند ضعیف II به صفحه پایینی و یا بالایی اتصال می‌یابد. این پیوند ضعیف

باعث می‌شود تا لایه‌ها روی یکدیگر بلغزند. به همین دلیل است که گرافیت حالت نرم دارد و همچنین پیوند^{II} باعث رسانندگی بالای گرافیت نیز می‌شود^[۳].

طول پیوند σ در صفحه گرافیتی $142 \text{ nm} / ۰$ است که از فواصل بین اتمی الماس کمتر است اما فاصله بین



شکل (۱-۴) ساختار گرافیت.

صفحات $341 \text{ nm} / ۰$ است. درنتیجه چگالی در صفحات، بسیار بالا است اما به دلیل دوربودن صفحات از هم، گرافیت چگالی کمتری نسبت به الماس دارد. گاف اپتیکی در حدود $4 \text{ eV} / ۰$ است. از این جهت و ازلحاظ رسانایی شبه فلز به شمار می‌آید. گرافیت در $5 \mu\text{m} = \lambda / ۵۲$ دارای ضریب شکست $2 / ۵۲$ می‌باشد.

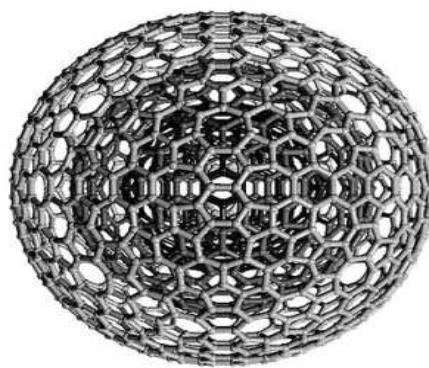
در صنعت، به خاطر بالا بودن دمای ذوب گرافیت از آن برای ساخت بوتهای نسوز و الکترودهای کوره در صنایع تولید برنج، مس و مفرغ استفاده می‌شود. مخلوط گرافیت با روغن به علت نرم بودن آن برای روغن کاری دستگاهها جهت جلوگیری از اصطکاک به کار می‌رود. گرافیت در ساخت مداد، با رس دانه ریز مخلوط می‌شود.

در مصارف الکتریکی به علت مقاومت کم و رسانای خوب به عنوان الکترود استفاده می‌شود.

فلورن

فلورن C_{60} اولین مولکول کروی شکل کربن می‌باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط کروتو و اسمالی در حین طیف‌سنجی نمونه‌های بخار کربن کشف شد [۴].

اتم‌های کربن در آن به صورتی قرار گرفته‌اند که شکلی مشابه یک توپ فوتبال را می‌سازند. در ساختار این مولکول شخصت اتم کربن وجود دارد. البته انواع دیگری از فلورن‌ها با تعداد اتم کربن بیشتر و یا کمتر نیز وجود دارند مانند C_{70} و C_{84} . کربن C_{60} به صورت حجیم و هم به صورت لایه نازک در دمای اتاق به عنوان یک نیمه‌رسانا عمل می‌کند. با افزودن نمک‌های فلزات قلیایی خاکی می‌توان مقاومت الکتریکی را چندین برابر کاهش داد. هم چنین فلورن را می‌توان به صورت یک تک لایه روی سطح پوشش داد. فلورن‌های تهیه شده را می‌توان در مکان‌های مشخص به صورت یک ردیف سنگ‌چین مانند، قرار داده و یک مدار الکتریکی ساخت.



شكل (۱-۵) ساختار فلورن

کربن شبه الماسی

لایه‌های نازک کربنی اولین بار توسط آیزنبرگ و چابوت در سال ۱۹۷۱ تهیه شده‌اند. در حالی که آن‌ها در حال لایه‌نشانی Si به روش کندوپاش Si جامد بودند تصمیم گرفتند به جای هدف Si از کربن استفاده کنند. با مطالعه خواص لایه‌های تهیه شده به این نتیجه رسیدند که ماده تولید شده بر خلاف همه کربن‌های متعارف است که همه می‌شناسند. خواصی چون سختی مکانیکی بالا، خنثایی شیمیایی، شفافیت اپتیکی و گاف نواری عریض

باعث شد که این لایه‌ها را کربن شبکه الماسی (DLC)^۱ بنامند.

در ابتدا واژه DLC برای لایه‌های سخت و بدون هیدروژن به کار می‌رفت، اما در حال حاضر گروه‌هایی از مواد که به عنوان DLC معرفی می‌شوند عبارتند از[۵]:

۱) کربن‌های آمورف (a-C)^۲

۲) کربن‌های آمورف هیدروژن‌دار (a-C:H)^۳

کربن آمورف (a-C) و (ta-C)

این لایه‌ها به روش تبخیر یا کندوپیاش از یک هدف گرافیتی با خلوص بالا تهیه می‌شوند. این نوع لایه‌ها بیشتر شامل پیوندهای sp² هستند. در این لایه‌ها کمتر از یک درصد هیدروژن وجود دارد بنابراین دست‌های آزاد که به دلیل نبود هیدروژن وجود دارند، رسانش را در آن‌ها افزایش می‌دهند.

کاف اپتیکی این لایه‌ها نزدیک به شبکه فلزات و در محدوده eV ۰—۰/۴ قرار می‌گیرد.

به منظور به‌دست آوردن ماده‌ای با ویژگی‌های نزدیک به الماس، تهیه کربن‌های آمورف که حاوی تعداد زیادی sp³ باشد، بسیار مطلوب است. در روش کندوپیاش و PECVD^۴ تعداد پیوندهای sp³ افزایش پیدا می‌کند. با افزایش sp³، ta-C به a-C^۵ تبدیل می‌شود زیرا پیوندهای چهاروجهی به سبب این نوع هیبریداسیون فراوان هستند.

Diamond Like Carbon^۱

amorphous carbon^۲

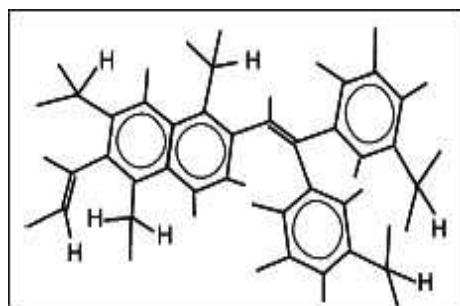
Hydrogenated amorphous carbon^۳

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition^۴

tetrahedral amorphous carbon^۵

(ta-C:H) و (a-C:H) آمورف هیدروژن دار کربن

کربن های هیدروژن دار شامل کربن های هیدروژن دار سخت، نرم و تراهدرال (ta-C:H) می باشند. شکل گیری هریک از آن ها به انرژی یون های کربن، هیدروژن و گونه های خنثی در طی فرایند لایه نشانی بستگی دارد.



شکل (۱-۶) ساختار لایه های کربن شبه الماسی هیدروژن دار.

(۱) نرم (a-C:H)

این نوع کربن های آمورف هیدروژن دار هنگامی که انرژی یون ها به چند ده الکترون ولت می رسد، به وجود می آیند. این لایه ها شامل 40° درصد پیوندهای sp^3 هستند و گاف اپتیکی آن ها در حدود 4 eV است که این ویژگی آن ها را برای کاربردهای اپتوالکترونیک مفید می سازد. اما به هر حال چگالی پایین و ویژگی های ضعیف مکانیکی این لایه ها، کاربرد آن ها را محدود ساخته است.

(۲) سخت (a-C:H)

هنگامی که انرژی الکترون ها کمتر از 100 eV می شود لایه های (ta-C:H) سخت به دست می آیند. این لایه ها نسبت به لایه های (a-C:H) نرم هیدروژن کمتر اما ویژگی های مکانیکی فوق العاده ای دارند. پیوندهای sp^3 تشکیل دهنده آن ها کمتر از 40° درصد می باشد. گاف اپتیکی این لایه ها در حدود 2 eV یا کمی بیشتر می باشد.

(۳) (ta-C:H)

هنگامی که انرژی یون ها در طی فرایند لایه نشانی به 100 eV می رسد، (a-C:H) سخت به (ta-C:H) با میزان sp^3 بالا در حدود 70° درصد تبدیل می شود. میزان هیدروژن در آن ها بسیار کم و در حدود 3°